Известия НАН Армении, Физика, т.58, №4, с.564–571 (2023) УДК 535.37 DOI:10.54503/0002-3035-2023-58.4-564

ФОТОИНДУЦИРОВАННЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ РЕШЕТКИ В КРИСТАЛЛЕ РУБИНА ПРИ ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКЕ СОСТОЯНИЯ ²*T*₁

В.С. АРАКЕЛЯН

Институт физических исследований НАН Армении, Аштарак, Армения

e-mail: vladimirarakelyan05@gmail.com

(Поступила в редакцию 25 мая 2023 г.)

Методом рассеяния Мандельштама–Бриллюэна исследовано колебательное поведение тяжелой примеси замещения (Cr^{3+}) в Al₂O₃. Колебания ионов хрома осуществляются фотовозбуждением. Впервые наблюдены дискретные смещения линий люминесценции рубина R₁ и R₂ при комнатной температуре в зависимости от поглощенной мощности лазерного излучения и при возбуждении состояния ²*T*₁. Эти смещения обусловлены возбуждением квазилокальных колебаний ионов хрома. Частота квазилокальных колебаний составляет 22 ГГц, что соответствует поперечным акустическим колебаниям в кристалле рубина. Дано объяснение наблюдаемого явления на основе адиабатического приближения Борна–Оппенгеймера и функции Пекара.

1. Введение

Фононные повторения линии люминесценции и рассеяние падающей ультразвуковой волны на примеси в случае, когда имеет место резкий резонанс в сечении рассеяния ультразвуковой волны, подробно исследованы в работах [1–7]. Многофононное антистоксовое возбуждение в пределе слабой связи наблюдал Аузель [8]. Доказательства многомодового состояния Пекара приведены в работе [9]. Влияние структурных вакансий на колебания решетки рассматривалось в работе [10]. Сильное влияние колебаний решетки на электронные и магнитные свойства материалов изучалось в работе [11]. Целью настоящей работы является исследование колебаний тяжелой примеси Cr³⁺ в лазерном кристалле рубина, вызванных ее фотовозбуждением.

2. Методология

Известно, что монохроматичность лазерного излучения и селективный характер взаимодействия излучения с энергетическими уровнями иона обеспечивают сильно выраженную селективность возбуждения определенных квантовых состояний энергетических уровней, соответствующих резонансным условиям их взаимодействия с полем излучения. Электронно-колебательные взаимодействия играют определяющую роль в процессе безызлучательной релаксации энергии возбужденных электронных состояний, таких как уровни $\bar{E}a$, $2\dot{A}$ и $\bar{E}b$ состояния ${}^{2}T_{1}$. Результатом дезактивации электронного возбуждения иона является его переход в электронное состояние с меньшей энергией (от ${}^{2}T_{1}$ до ${}^{2}E$) и превращение выделяемой энергии в колебательную энергию. Количество возбужденных электронно-колебательных уровней определяется шириной спектра и мощностью когерентного источника возбуждения. Чтобы колебательная мода могла поглощать, должны быть выполнены законы сохранения энергии и импульса и должен существовать механизм связи между материалом и падающим излучением. Механизм связи между падающим фотоном и фононом осуществляется изменением состояния электрического дипольного момента. Эти диполи могут поглощать энергию падающего излучения, достигая максимальной связи с излучением, когда его частота равна частоте колебательной моды диполя [12]. В зависимости от степени возбуждения колебаний диполь может излучать определенное количество одинаковых фононов с энергией $\hbar\Omega$ каждый. При больших энергиях электронного перехода возможны только многофононные переходы, когда один переход связан с испусканием нескольких фононов. Количество генерируемых оптическим путем фононов оказывается пропорциональным поглощенной энергии возбуждения [13].

При рассмотрении взаимодействия электронной подсистемы с квазилокальными колебаниями можно использовать гармоническое приближение, если частота локальной моды не меняется и в адиабатическом приближении отсутствует взаимодействие между локальными колебаниями и колебаниями основной решетки. Если при электронном переходе система переходит в другое колебательное состояние, то меняются конфигурационные координаты и частоты колебаний. Из-за разницы положений равновесия после электронного перехода центр находится в другом колебательном состоянии. Физическая основа модели конфигурационных координат для описания оптических свойств локализованных центров в твердых телах основана на адиабатическом приближении Борна-Оппенгеймера [14]. В модели конфигурационных координат положение равновесия ионов в основном электронном состоянии Q = 0 (рис.1). В возбужденном электронном состоянии положение равновесия находится при Q = A и в целом, форма кривой потенциальной энергии отличается от формы кривой основного состояния. Наличие колебаний примесного иона приводит к смещению положения иона на ΔQ и появлению фононных повторений линии люминесценции.



Рис.1. Сдвиг положения иона на ΔQ в конфигурационных координатах.

Вероятность перехода с участием *n* колебательных квантов при 0 К равна:

$$P_{n0} = e^{-S} s^n / n!. (1)$$

Уравнение (1) определяет форму функции Пекара *P*_{n0} [15]. Здесь *n* – число фононов, *S* – фактор Хуанга–Риса, а

$$S = E_2/\hbar\omega = n\hbar\omega'/\hbar\omega, \qquad (2)$$

где E_2 – поглощенная энергия, $\hbar\omega$ и $\hbar\omega'$ – колебательные энергии основного и возбужденного состояний, соответственно. Величина *S* пропорциональна *n* и в приближении $\hbar\omega' \approx \hbar\omega$ (что справедливо в случае чисто линейной связи с модой *Q*) равна числу фононов *n*). Из уравнения (1) и рис.2 видно, что функция Пекара существенно меняет форму и положение максимума огибающей в зависимости от фактора Хуанга–Риса *S*.

Фактор Хуанга–Риса *S* является мерой силы линейной электрон-фононной связи и характеризует среднее число фононов, сопровождающих конкретный электронный переход [15, 16]. Согласно принципу Франка–Кондона, когда квант света поглощается, происходят переходы из основного состояния в «поворотные точки» колебательных состояний возбужденного электронного состояния. Как видно из уравнения (1) и рис.2, при увеличении *S* вероятность безфононной линии уменьшается экспоненциально и наблюдается на практике только при $S \le 6$. Если дисперсия фононов мала, взаимодействие фононов с электронами, связанными с примесными центрами, создают систему дискретных частот при низких температурах [17]. Квазилокальные колебания охватывают весь кристалл, но амплитуда примесных колебаний значительно превышает амплитуду колебаний ионов решетки.



Рис.2. Форма функции Пекара для S = 0.1, S = 3 и S = 6, n = 0 – положение бесфононной линии.

Наличие колебаний иона тяжелой примеси приводит к смещению положения тяжелого иона, частота колебаний которого попадает в низкочастотную часть акустического диапазона частот [17]. Спектральная плотность колебаний имеет узкий резонансный пик на квазилокальной частоте [16, 18]. Эти колебания можно интерпретировать как принадлежащие связанным состояниям фонона с примесным центром или как своеобразные локальные моды [19].

Если примесь намного тяжелее замещаемого ею иона или если эффективные силовые константы, описывающие взаимодействие примеси с ее соседями малы по сравнению с константами решетки-хозяина, сильный резонанс в сечении рассеяния падающего ультразвука от примеси может возникать для частот, малых по сравнению с дебаевской частотой [1, 19–22]. При взаимодействии электронного перехода с квазилокальными колебаниями в оптическом спектре появляются колебательные повторения безфононной линии, расположенные эквидистантно $\hbar \omega \pm n \hbar \Omega_{qloc}$. Здесь ω – частота безфононной линии и Ω_{qloc} – частота квазилокальных колебаний.

Локализованные колебания решетки исследуются в основном методом комбинационного рассеяния (сдвиг линии люминесценции $\geq 100 \text{ см}^{-1}$) [2, 8, 9, 23]. При комнатной температуре линии люминесценции уширены и невозможно фиксировать низкочастотные колебательные повторения линии люминесценции. Можно наблюдать лишь смещение пиков люминесценции за счет изменения формы функции Пекара и, соответственно, изменения положения пиков огибающих люминесценции (рис.2).

3. Аппаратура и методы исследования

Люминесценцию рубинового лазерного кристалла с концентрацией хрома 0.05 мас% и длиной 12 см исследовали при возбуждении галогенной лампой и лазерным диодом (LD). Оптическое возбуждение ионов Cr^{3+} из основного состояния ${}^{4}A_{2}$ в состояние ${}^{2}T_{1}$ (уровни Ea, $2\dot{A}$) осуществляли с помощью LD-лазера. Сканирование состояния ${}^{2}T_{1}$ реализовывалось в диапазоне длин волн 658.5–662.1 нм или в волновых числах 15186–15102.5 см⁻¹. Возбуждение и регистрация люминесценции осуществлялись под прямым углом друг к другу. Спектры люминесценции регистрировали на спектрометре ДФС-24 с разрешением 0.5 Å на длине волны 550 нм. Люминесценция R-линий наблюдалась в направлении, перпендикулярном направлению возбуждения, через кварцевый световод. Излучение LD-лазера фокусировалось в кристалл рубина линзой с фокусным расстоянием ~5 мм, установленной на корпусе лазера. Исследовалось поведение линий люминесценции R₁ и R₂ в зависимости от интенсивности и волнового числа LD-лазера.

Интенсивность и частота LD-лазера изменялись током источника питания. Все измерения проводились при комнатной температуре. Линии люминесценции R_1 и R_2 возбуждались опосредованно через промежуточное электронное состояние 2T_1 , уровни $2\dot{A}$ и \bar{E} а которого перекрываются при комнатной температуре.

4. Экспериментальные результаты и их обсуждение

Исследована зависимость мощности LD-лазера от волнового числа излучения. Как показано на рис.3, эта зависимость близка к линейной. На рис.4 и рис.5 показано положение пиков люминесценции линий R₁ и R₂, соответственно, в зависимости от волнового числа излучения при различной мощности LD-лазера. При возбуждении уровней Ea и 2*A* состояния ²*T*₁ волновое число излучения LD-лазера изменялось от 15186.12 см⁻¹ до 15102.6 см⁻¹. При этом мощность лазера также изменялась от 39 до 219 мВт. В ходе эксперимента наблюдалось дискретное смещение положения максимумов линий люминесценции (рис.4,5) при изменении мощности и волнового числа возбуждающего лазера. Смещение пиков интенсивности люминесценции линий R₁ и R₂ ≈ *n* раза 0.52 см⁻¹, где *n* — целое число и 0.52 см⁻¹ соответствует частотному сдвигу максимумов люминесценции $\Delta v_i \approx 15.6$ ГГц.



Рис.3. Зависимость мощности LD-лазера от волнового числа излучения.

Положение пика люминесценции линии R_1 при возбуждении галогенной лампой соответствует значению 14404.2 см⁻¹. При облучении кристалла рубина LD-лазером (при мощности излучения лазера 39 мВт и волновом числе 15186.1 см⁻¹) наблюдаемое значение волнового числа для пика люминесценции линии R_1 составило 14405.7 см⁻¹. Разница в расположении пиков люминесценции при возбуждении LD лазером или галогенной лампой составляет $\Delta R_1 \approx 1.55$ см⁻¹ и $\Delta R_1/0.52 \approx 3$.

Положение пика люминесценции линии R₂ при возбуждении галогенной лампой соответствует значению 14434 см⁻¹. При облучении кристалла рубина LD-лазером (при мощности излучения 39 мВт и волновом числе 15186.1 см⁻¹) наблюдаемое значение волнового числа для пика люминесценции линии R₂ составило 14436 см⁻¹. Разница в расположении пиков люминесценции при возбуждении LD-лазером или галогенной лампой составляет $\Delta R_2 \approx 2$ см⁻¹, $\Delta R_2/0.52 \approx 4$. Максимальное смещение пиков линий люминесценции R₁ и R₂ $\Delta_{max} \approx 6$ раза 0.52 см⁻¹ (рис.4 и 5).



Рис.4. Спектр поглощения состояния ${}^{2}T_{1}$ (кривая *1*) и положение пиков интенсивности линии люминесценции R₁ в зависимости от волнового числа излучения LD-лазера и его мощности (кривая *2*), ω – частота безфононной линии и Ω – частота квазилокальных колебаний; $\Omega = 0.52$ см⁻¹ (15.6 ГГц) при наблюдении люминесценции под углом $\theta = 90^{\circ}$.



Рис.5. Спектр поглощения состояния ${}^{2}T_{1}$ (кривая *1*) и положение пиков интенсивности линии люминесценции R₂ (кривая *2*) в зависимости от волнового числа излучения лазера. Здесь ω – частота безфононной линии и Ω – частота квазилокальных колебаний. Мощность излучения лазера такая же, как на рис.4.

Сдвиг пиков люминесценции при возбуждении состояния ${}^{2}T_{1}$ при мощности излучения 39 мВт составляет 1.55 см⁻¹ (1.55/0.52 \approx 3) для линии R₁ и 2 см⁻¹ для линии R₂ (2/0.52 \approx 4 при той же мощности возбуждения). В работе [14] было показано, что при увеличении фактора Хуанга–Риса *S* вероятность безфононной линии уменьшается экспоненциально и наблюдается на практике только при $S \leq 6$. Таким образом, отсутствие смещения пиков люминесценции в верхней части рис.5 и рис.6 можно объяснить перераспределением интенсивностей люминесценции в зависимости от интенсивности возбуждения в соответствии с уравнением (1). Уменьшение смещения пиков люминесценции в левой части рис.4 и 5 можно объяснить уменьшением поглощаемой энергии.

Появление комбинационных частот и их количество зависят от поглощенной энергии, так как она определяет величину смещения возбужденного иона Cr^{3+} . Увеличение амплитуды колебаний ионов, вызванное увеличением поглощаемой энергии, приводит к увеличению параметра Хуанга–Риса *S*. Это увеличение приводит к изменению формы функции Пекара и смещению положения пика (рис.2 и 4). Представленные результаты согласуются с теорией [15–17].

5. Заключение

При комнатной температуре наблюдались дискретные смещения пиков линий люминесценции R_1 и R_2 рубина в зависимости от поглощенной мощности лазера при возбуждении состояния 2T_1 . Эти смещения обусловлены возбуждением квазилокальных колебаний иона хрома. Дискретное смещение линий люминесценции в кристалле рубина, вызванное квазилокальными колебаниями обнаружено впервые. Частота квазилокальных колебаний равна 22 ГГц. Судя по частоте бриллюэновского рассеяния, полученной в эксперименте, наблюдаемые колебания относятся к поперечным акустическим колебаниям. Сдвиг пиков люминесценции на 0.52 см⁻¹ (сдвиг частоты 15.6 ГГц) обусловлен возбуждением квазипоперечной гиперзвуковой волны. Бриллюэновское рассеяние наблюдалось под углом $\theta = 90^\circ$. Измеренный сдвиг частоты $\Omega - 15.6$ ГГц. По формуле Бриллюэна ($\Omega = 2\omega nv/c \sin \theta/2$) под углом наблюдения $\vartheta = 180^\circ$ этот сдвиг соответствует смещению линии люминесценции – 0.735 см⁻¹ (сдвиг частоты – 22 ГГц). Здесь ω – оптическая частота, n – показатель преломления, v и c – соответственно скорость распространения звуковой волны и скорость света. Указанный сдвиг люминесценции хорошо согласуется с расчетными данными для квазипоперечной гиперзвуковой волны 0.74 см⁻¹ для направления [100] при обратном рассеянии [24].

Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета по науке PA в рамках проекта N 1-6/23-I/IPR.

Автор выражает благодарность сотрудникам института за полезные обсуждения и сотрудникам лаборатории за помощь при выполнении работы.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. D.L. Mills. J. de Physique, 28, C1 (1967).
- V.I. Sokolov, E.A. Shirokov, A.N. Kislov, V.G. Mazurenko. Phys. Stat. Sol. (b), 221, 553 (2000).
- 3. A.P. Saiko. https://arxiv.org/abs/physics/0412160.
- 4. D. Schmeltzer, R. Beserman. J. Phys. C. Sol. Stat. Phys. 14, 27 (1981).
- 5. B. Canny, J.C. Chervin, D.C. Veronique, L. Jing-Quing. SPIE, 74, 1182 (1989).
- Y. Zhangt, J.S. Zheng, D.L. Mi, B.Z. Yan, B.X. Wu. J. Phys., Condens. Matter, 2, 5219 (1990).
- I.S. Altman, P.V. Pikhitsa, M. Choi, A.G. Nasibulin, E.I. Kauppinen. Phys. Rev. B, 68, 125324 (2003).
- 8. F. Auzel. Phys. Rev. B, 13, 2809 (1976).
- M. Nazarova, M.G. Brike, D. Spasskye, B. Tsukerblate, A. Paliib, N. Nazida, M.N. Ahmad-Fauzi. Phys. Lett. A, 377, 3170 (2013).
- 10. T.-H. Dong, X.-D. Zhang, L.-M. Yang, F. Wang. Chinese Phys. B, 31 026101 (2022).
- B. Alling, F. Körmann, B. Grabowski, A. Glensk, I.A. Abrikosov, J. Neugebauer. Phys. Rev. B, 93, 224411 (2016).
- 12. C. Kittel. Introduction to Solid State Physics. Berkeley, JohnWiley & Sons, 2004.
- 13. R.J. G.Goossens, J.I. Dijkhuis, H.W. de Wijn. Phys. Rev. B, 32, 5163 (1985).
- 14. J.J. Markham. Rev. Mod. Phys., 31, 956 (1959).
- 15. K. Huang, A. Rhys. Proc. Roy. Soc., 204, 406 (1950).
- 16. A. Hughes. Physique Colloquesm., 28, 55 (1967).
- 17. G. Leibfried. Microscopic Theory of Mechanical and Thermal Properties of Crystals, in Handbuch der Physik, S. Fligge (Ed.), vol. 7, ch. 1, Berlin, Springer-Verlag, 1955.
- 18. M. Born, H. Kun. Dynamical Theory of Crystal Lattices, Oxford, Clarendon Press, 1988.
- 19. E.I. Rashba, A.B. Zimin. Sov. Phys. JETP, 39, 1479 (1974).
- 20. R. Brout, W. Visscher. Phys. Rev. Lett, 9, 54 (1962).
- 21. A.J. Sievers, S. Takeno. Phys. Rev. A, 140, 1030 (1965).
- 22. W. Visscher. Phys. Rev., 28, 1299 (1963).
- V.I. Sokolov, E.A. Shirokov, A.N. Kislov, V.G. Mazurenko. J. Cryst. Growth, 214, 304 (2000).
- 24. G.V. Krivoshchekov, M.F. Stupak. Sov. J. Quantum Electron., 5, 1397 (1975).

ՍՈՒՏԱԿԻ ԲՅՈՒՐԵՂՈՒՄ ՑԱՆՑԻ ԼՈՒՍԱՄԱԿԱԾՎԱԾ ՏԵՂԱՅԻՆ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ² 7 ՎԻՃԱԿԻ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԳՐԳՌՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Վ.Ս. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Բրիլյուենի ցրման եղանակով հետազոտվել է Al₂O₃ միաբյուրեղում Cr³⁺ տեղակալող ծանր խառնուկի տատանողական վարքը։ Քրոմի ինոնների տատանումներն իրագործվում են վերջիններիս լուսագրգռման միջոցով։ Առաջին անգամ սենյակային ջերմաստիձանում դիտվել են սուտակի R₁ և R₂ լյումինեսցենտ գծերի ընդհատ (դիսկրետ) շեղումներ ${}^{2}T_{1}$ վիձակի գրգռման դեպքում՝ կախված լազերային մղման կլանված հզորությունից։ Այդ շեղումները պայմանավորված են քրոմի ինոնների քվազիտեղային տատանումների գրգռումով։ Քվազիտեղային տատանումների հաձախությունը կազմում է 22 ԳՀց, որը համապատասխանում է սուտակում լայնական ակուստիկ (ձայնային) տատանումներին։ Տրվել է դիտարկված երևույթի բացատրություն Բորն-Օպենհեյմերի ադիաբատիկ մոտարկման և Պեկարի ֆունկցիայի հիման վրա։

PHOTOINDUCED LOCAL LATTICE VIBRATIONS IN A RUBY CRYSTAL UNDER OPTICAL PUMPING OF THE ${}^{2}T_{1}$ STATE

V.S. ARAKELYAN

The vibrational behavior of a heavy substitutional impurity (Cr^{3+}) in Al₂O₃ has been studied by the Brillouin scattering method. The vibrations of chromium ions are carried out by their photoexcitation. Discrete shifts of the ruby luminescence lines R₁ and R₂ at room temperature are observed depending on the absorbed laser pump power upon excitation of the ${}^{2}T_{1}$ state. These shifts are due to the excitation of quasi-local vibrations of chromium ions. The frequency of quasi-local oscillations is 22 GHz, which corresponds to transverse acoustic oscillations in ruby. An explanation of the observed phenomenon is given on the basis of the Born-Oppenheimer adiabatic approximation and the Pekar function.